

	<p><b>SPB10N10L G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPB10N10L G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 10.3A TO-263</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPB10N10L G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29800 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SPB10N10L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10.3A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 21µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	154 mOhm @ 8.1A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	444pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.3A (Tc)

SPB10N10L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB10N10L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB10N10L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPB10N10L G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPB11N60C3</b> Infineon Technologies SPB11N60C3 Infineon Technologies</p>	 <p><b>SPB11N60C3ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK</p>	 <p><b>SPB11N60C3ATMA1</b> INFINEON INFINEON TO263</p>	 <p><b>SPB10N10L</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK</p>
 <p><b>SPB10N10 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK</p>	 <p><b>SPB10N10G</b> INFINEON SPB10N10G INFINEON</p>	 <p><b>SPB106-AP-1</b> H&amp;D Wireless AB WIFI BRD W/RF ANTENNA 802.11B/G</p>	 <p><b>SPB11N60C2</b> VB SPB11N60C2 VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB10N10L G International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB10N10L G Datenblatt	SPB10N10L G-Datenblätter	SPB10N10L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB10N10L G
SPB10N10L G Electronic	SPB10N10L G-Komponenten	SPB10N10L G-Verteiler	SPB10N10L G-Bild	SPB10N10L G-Teil
SPB10N10L G Preis	SPB10N10L G Hersteller	SPB10N10L G Bild	SPB10N10L G Aktie	SPB10N10L G Inventar
SPB10N10L G Neu	SPB10N10L G Original	SPB10N10L G garantiert	SPB10N10L G RFQ	SPB10N10L G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited